

公司代码：688693

公司简称：锆威特

**苏州锆威特半导体股份有限公司**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，并提请投资者特别关注如下风险。

业绩大幅下滑的风险：报告期内，公司实现营业总收入 21,374.33 万元，较上年同期下降 9.19%；实现归属于母公司所有者的净利润为 1779.50 万元，较上年同期下降 70.89%。2023 年度受宏观经济环境、行业周期等因素影响，功率半导体市场整体表现低迷，终端市场需求不及预期，产品销售价格承压，同时研发费用等经营性费用同比提升，导致全年业绩大幅下滑。若未来功率半导体行业景气度持续下滑导致市场需求出现重大不利变化，下游客户抗周期波动能力不足或出现经营风险，将会对公司营收规模及毛利率产生不利影响。公司经营业绩受功率半导体行业景气度影响较大，存在周期性波动的风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本73,684,211股，以此计算合计拟派发现金红利12,526,315.87元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调

整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	锲威特	688693	不适用

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	严泓	王勇
办公地址	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室
电话	0512-58979950	0512-58979950
电子信箱	zhengq@convertsemi.com	zhengq@convertsemi.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，可实现电源开关和电能转换的功能，实现变频、变相、变压、逆变、变流、开关的目的。公司坚持“自主创芯，助力核心芯片国产化”的发展定位，始终围绕功率半导体产品不断进行业务开拓和持续创新，主要产品包含功率器件及功率 IC 两大类。在功率器件方面，公司产品以高压平面 MOSFET 为主，并在平面 MOSFET 工艺平台基础上设计研发了集成快恢复高压功率 MOSFET（FRMOS）系列产品；在功率 IC 方面，公司产品主要包括 PWM 控

制 IC 和栅极驱动 IC。此外，在第三代半导体方面，公司的 SiC 功率器件已顺利实现产品布局并进入产业化阶段。主要产品如下：

### 1. 功率器件方面


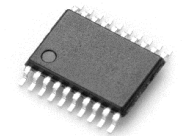
公司功率器件产品以 MOSFET 为主，公司是国内为数不多的具备 650V-1700V SiC MOSFET 设计能力的企业之一，产品已覆盖业内主流电压段。功率器件产品如下：

产品种类	封装后成品示意图	产品特点	覆盖参数段	主要应用方向
平面 MOSFET		具有功率密度高、产品击穿耐压稳定性高、阈值电压一致性好、高温漏电小、开关损耗小、抗浪涌能力强等性能特点	电压范围： <u>40V-1500V</u> 电流范围： <u>0.3A-190A</u>	公司产品广泛用于 LED 照明、电源适配器、智能家电、PC 电源、逆变器、智能电表等
集成快恢复高压功率 MOSFET (FRMOS)		采用重金属掺杂工艺制造，具有低反向恢复电荷、反向恢复时间短和低高温漏电流的特性	关键动态指标反向恢复电荷 $Q_{rr} < 0.2\mu C$ 反向恢复时间 $T_{rr} < 100ns$ 电压范围： <u>300V-700V</u> 电流范围： <u>2A-94A</u>	公司产品主要应用于直流无刷电机驱动、LLC 架构的大功率电源、高功率数字音频功放等
沟槽型 MOSFET		具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点	电压范围： <u>30V-150V</u> 电流范围： <u>4A-300A</u>	可广泛用于电动工具、智能家电主板等
超结 MOSFET		公司超结 MOSFET 采用多次外延工艺，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低等特点	电压范围： <u>600V-800V</u> 电流范围： <u>4A-80A</u>	可广泛用于新能源汽车充电桩、服务器电源、通讯电源
SiC MOSFET		导通电阻小，开关损耗低，工作温度范围宽，阈值电压一致性好	电压范围： <u>650V-1700V</u> 电流范围： <u>3A-200A</u>	可广泛用于新能源汽车及配套、工业照明、大功率电源、高可靠领域等
SiC SBD		反向恢复时间短，反向恢复电荷小，工作温度范围宽	电压范围： <u>650V-1200V</u> 电流范围： <u>2A-60A</u>	可广泛用于新能源汽车及配套、大功率电源、逆变器、高可靠领域等

### 2. 功率 IC 方面

公司功率 IC 产品主要包括 PWM 控制 IC 和栅极驱动 IC，相关产品如下：

产品种类	封装后成品示意图	产品特点	覆盖参数段	主要应用方向
------	----------	------	-------	--------

产品种类	封装后成品示意图	产品特点	覆盖参数段	主要应用方向
PWM 控制 IC		产品主要为隔离式开关电源芯片，用于将输入电压的振幅转换成宽度一定的脉冲，使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定。产品涵盖反激、反激双路交错、正激有源钳位、推挽、半桥、全桥、移相全桥等多拓扑配置，帮助客户灵活创建各种电源设计；同时集成了欠压、过压、过流、过热等多种保护功能，确保系统安全稳定工作	工作电压范围： <u>13V-120V</u> 开关频率支持 1MHz 以上	可广泛用于安防、工业电源等
栅极驱动 IC		产品主要为电机驱动 IC，包含单相半桥、全桥、三相全桥产品系列，用于将电机控制器/MCU 输出的低压控制信号转换成驱动功率器件的高压驱动信号，集成了高侧和低侧驱动器，可降低开关损耗，适应嘈杂的环境并提高系统效率，支持 TTL 和 CMOS 电平输入，低传输延迟、内部集成电荷泵，支持 100% 占空比工作	工作电压范围： <u>20V-600V</u> 驱动电流最高可达 10A 开关频率可支持 1MHz 以上	可广泛用于电机驱动、工业电源等

### 3. 技术服务

公司在开发产品的同时，利用长期积累的设计经验和工艺开发能力，为客户提供芯片设计及工艺开发等技术服务，公司技术服务主要覆盖高可靠领域客户，包括产品开发和工艺开发流片两类。

**产品开发：**在该类技术服务过程中，由客户定义产品的功能和参数指标，委托公司对该产品进行设计开发，后续公司根据客户的具体需求，可以为客户提供制版、流片和测试验证等技术服务工作。

**工艺开发流片：**客户基于晶圆厂已有工艺平台，需要开发新的器件或者其他工艺升级要求。在工艺开发流片的服务过程中，由公司负责新器件工艺开发或为客户提供其指定需求的工艺服务。后续由客户基于公司提供的工艺服务自行设计产品，并委托公司进行制版、流片的服务。而产品的测试验证等工作由客户自行负责。

#### (二) 主要经营模式

公司为采用 Fabless 经营模式的芯片设计企业，将晶圆制造和封测环节委外，晶圆代工厂根据公司提供的产品设计版图、工艺制程要求完成晶圆的加工制造，经公司验收后，公司再根据市场需求对其进行委外封装和测试。通过将制造、封装、测试环节委外，公司可将研发力量集中于功率半导体芯片设计环节，专注于自身所擅长的领域，提升核心竞争力；同时 Fabless 经营模式较

IDM 经营模式更为灵活，公司可快速根据市场变化进行产品结构调整。

### 1、研发模式

公司制定了系统的研发管理制度和版图设计流程规范，包括《产品设计开发控制程序》《版图设计管理规定》《产品验证管理规定》《工程封装管理规定》等，对研发过程中各个环节进行了规范，保证设计研发产出符合公司要求规定，从而提升研发产出效率和成功率。研发流程主要包括论证阶段、设计阶段、工程试制阶段和定型阶段。

### 2、采购模式

公司采购内容主要包括晶圆和封装测试服务。公司自主设计研发相关产品，再委托晶圆代工厂商生产并向其采购。晶圆采购根据公司是否提供原材料外延片分为直接委外和带料委外两种采购形式：对于直接委外，晶圆代工厂自行采购外延片并根据公司设计版图（公司设计版图的具体载体为 GDS 文件或掩膜版）及工艺要求制造出公司所需晶圆，向公司销售加工后晶圆；对于带料委外，由公司提供外延片，晶圆代工厂仅负责晶圆制造，根据公司提供的设计版图及工艺要求制造出公司所需晶圆，并向公司收取加工费。两种模式所采购晶圆均为公司自主设计研发。对于加工后晶圆，晶圆代工厂具备中测条件的，公司会直接采购中测后晶圆，如晶圆代工厂不具备中测条件，公司采购加工后晶圆后，再另行委外中测，中测完成后入库。

公司制定了《采购控制程序》，对晶圆、外延片、封装、包辅料等采购流程制定了严格规定并遵照执行。公司还制定了《供应商开发和管理程序》《wafer 委外加工管理规定》《CP 委外加工管理规定》《封装委外加工管理规定》等规定，对各类外协采购进行严格管理和控制，保证外协采购内容满足公司要求。

### 3、销售模式

公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，主要直销客户多为业内知名的芯片设计公司及高可靠领域客户；经销客户为公司的经销商。公司的经销模式为买断式，属于行业内的常规模式。公司制定了《成品客户管理规定》《报价管理规定》《售后服务管理制度》《客户投诉处理控制程序》等规定，其中对经销商的导入、价格制定、客诉流程等方面均作出了详细规定，公司与经销商均签署《产品授权经销协议》，对双方的权利和义务作出明确规定。

## (三) 所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业的发展阶段、基本特点

公司主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。根据《中华人民共和国国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

我国功率半导体行业较西方国家起步较晚，受到企业规模及技术水平的制约，在高端功率半导体产品领域尚未形成整体的规模效应，单体规模较小，在技术能力、经验和客户积累上同国外企业存在一定差距。因此，中国功率半导体的进口量和进口占比仍然较大，尤其是用于工业控制领域的高性能产品及用于高可靠领域的产品，国产化替代空间较大。近年来，随着半导体产业的逐渐成熟，在国家政策导向引领下，功率半导体产业链自主可控进程加速，为国内功率半导体厂商提供了良好的发展机遇，国内企业近年来逐步打破国外技术垄断，国内产品可靠性、稳定性、性能参数等不断追赶国外竞品标准，预计未来国内功率半导体厂商市场份额将逐步提升。

报告期内，受到全球经济增长动能不足、地缘政治、半导体行业周期波动等多方位因素影响，功率半导体市场整体表现低迷，有效性需求不足，产品价格下跌，下游厂商库存水位较高，行业正处于下行周期，但功率半导体作为电子装置中电能转换与电路控制的核心，市场份额整体较为稳定，涉及电路控制和电能转换的产品均离不开功率半导体，功率半导体主要下游应用领域包括消费电子、工业控制、高可靠领域等，广阔的下游应用领域仍是功率半导体未来发展的重要支撑。

从目前功率器件的需求领域来看，根据 Yole 的预测，工业自动化、通信技术、光伏、新能源车等渗透率不断提升，功率器件将维持长期增长，预计到 2026 年，全球功率市场将达到 262.74 亿美元。从功率半导体市场结构来看，根据中商产业研究院数据显示，目前国内功率半导体市场中占比最多的是功率 IC，为功率半导体第一大细分市场。功率 IC 包括电源管理芯片、驱动芯片、AC/DC 转换器等，其中电源管理 IC 占比最高。据 Frost&Sullivan 数据，2025 年中国电源管理 IC 市场规模将达到 234.5 亿美元。

## （2）所属行业主要技术门槛

### 1) 功率器件的技术门槛

功率器件种类较多，主要包括二极管、三极管（BJT）、晶闸管、MOSFET 和 IGBT 等。其中，二极管、晶闸管、三极管（BJT）的优点是成本低，生产工艺相对简单，在中低端领域大量应用；MOSFET、IGBT 等器件结构相对复杂，工艺门槛和生产成本相对较高，系具有较高技术先进性的产品。根据 Yole 预测，到 2028 年功率器件将以 Si 基 MOSFET、IGBT、SiC 基 MOSFET 为主导，其中 MOSFET 在所有功率器件类别中占比最高，占比达 30%，需求保持稳定增长。

### 2) 功率 IC 的技术门槛

### ①对研发团队的专业能力要求较高

功率 IC 产品属于模拟 IC 的一种，在产品研发设计时需要在速度、功耗、增益、精度、电源电压、工艺、工作温度、噪声、面积等多种因素间进行考量。功率 IC 产品内部由多种功能模块电路构成，内部集成的功能模块有高精度低温漂的电压基准源、电流基准源、线性稳压器、高频振荡器、输出驱动模块及各种保护模块，需要充分考虑噪声、串扰等在各功能模块间的影响，每个功能模块电路均会影响到功率 IC 的性能指标，影响功率 IC 产品的研发速度和成功率，版图的布局布线的复杂度较高。因此对于功率 IC 设计公司来讲，需要相对专业资深的设计团队，不断进行功能模块 IP 电路的验证和储备，才能打磨出高性能的功率 IC 产品。

### ②工艺实现门槛高

功率 IC 产品集成了低压 CMOS、中压 CMOS、高压 CMOS、LDMOS、双极器件、各种阻容等多种器件，需采用高压 BCD 工艺来进行设计研发。由于功率 IC 产品的市场需求多样，晶圆代工厂提供的 BCD 工艺平台往往无法完全满足产品设计的要求，因此功率 IC 设计企业需同时具备产品设计研发及工艺开发能力，能够针对线路设计过程中的需求开发功率 IC 产品所需要的工艺平台。高压 BCD 工艺层次多，产品结构复杂，对功率 IC 产品研发提出较高的要求。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### (1) 功率器件

公司功率器件产品以 MOSFET 为主，长期以来，全球功率器件市场主要由国际厂商占据，以英飞凌、安森美、意法半导体、东芝、瑞萨为代表的国外品牌凭借先进制造优势、人才集聚优势、大规模研发投入和技术积累，目前占据全球 MOSFET 市场的主要份额。根据 Omdia 数据，以销售额计，2020 年 MOSFET 市场前七大品牌的市场占有率合计达到 68.09%，市场竞争格局相对稳定。中国功率器件产业起步较晚，随着功率器件行业国产替代进程加速，国产功率器件市场份额得到逐步提升。公司已同时具备 Si 基及 SiC 基功率器件的设计、研发能力，积累了多项具有原创性和先进性的核心技术，其中 3 项达到国际先进水平，1 项达到国内领先水平。SiC 基功率器件方面，公司是国内为数不多的具备 650V-1700V SiC MOSFET 设计能力的企业之一，产品已覆盖业内主流电压段。

### (2) 功率 IC

功率 IC 方面，公司产品主要包括 PWM 控制 IC 和栅极驱动 IC。PWM 控制 IC 方面，根据 QYResearch 相关数据，国际巨头如 TI（德州仪器）、ADI（亚德诺半导体）、英飞凌、安森美、意



法半导体等欧美公司在 PWM 控制 IC 领域总体处于领先地位，2021 年度 PWM 控制 IC 中国市场收入前 10 大公司均为国外公司。栅极驱动 IC 方面，根据芯谋研究相关数据，栅极驱动 IC 市场集中度相对较高，2021 年度栅极驱动 IC 中国市场收入前 10 大公司市场占有率合计达到 74.4%，其中欧日美公司总体处于领先地位。公司坚持在高可靠领域芯片国产化替代的战略方向，洞察市场需求导向，进行自主研发和创新，将科技成果与产业深度融合。公司凭借自身研发的高性能产品，已与多家高可靠领域客户建立合作关系；该特定应用领域对产品的性能有严格要求，公司产品得以进入该领域，表明了公司部分产品指标已达到国外竞品同等水平，并在其细分产品领域逐步实现国产化替代，公司在高可靠领域已取得一定的市场地位。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

#### (1) 海外龙头仍居第一梯队，国内厂商市场发展空间大

目前高端功率半导体产品仍然主要由美、日、欧龙头厂商主导，国内厂商与国外龙头公司仍存在较大差距。根据 Strategy Analytics 数据，2020 年全球功率半导体市场份额前五大公司占据近 70% 市场份额，其中英飞凌处于绝对领先地位，独占 30% 市场份额，市场份额前五大公司均为国外企业，国内厂商市场份额仅占 10% 左右，发展空间大。

#### (2) 第三代半导体材料带来新的发展机遇

以 SiC 为代表的第三代半导体材料给功率半导体行业带来了新的发展契机，SiC 材料相对于硅基材料主要拥有如下优势：耐高压、耐高温、工作频率高。

①耐高压 SiC 的击穿场强约为硅的 10 倍，这就意味着同样电压等级的 SiC MOSFET 晶圆外延层厚度只要硅的十分之一，是应用于超高压功率器件的理想材料。

②耐高温 SiC 的禁带宽度是硅基材料的 3 倍，SiC 的热导率是硅基材料的 2-3 倍，故 SiC 功率器件的应用可使散热器体积减小。

③高频 SiC 的电子饱和速度是硅基材料的 2-3 倍，SiC 功率器件可实现 10 倍于硅基功率器件的工作频率。

国家设立了 2030 年前碳排放达峰，2060 年前碳中和的双碳战略目标，未来制造业企业将进一步提升能源利用效率、减少碳排放，SiC 凭借低功耗、耐高压、耐高温、高频等优势特性，在助力国家实现碳中和战略目标方面具有重要作用，其应用前景广阔。

#### (3) 功率半导体的国产替代趋势逐渐加强

现阶段中国功率半导体的进口量和进口占比仍然较大，尤其是用于工业控制领域的高性能产品及用于高可靠领域的产品，国产化替代空间广阔。根据 CCID 的数据，中国功率半导体市场中，接近 90% 的产品均依赖进口。根据半导体行业观察、国金证券研究所数据，中国模拟芯片仍高度依赖进口，2020 年国产化率仅为 12% 左右。近年来，国产化替代需求随着中美贸易摩擦而更加迫切。近年来，国家颁布了《国家信息化发展战略纲要》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等政策，为功率半导体产业链自主可控提供了政策支持，功率半导体行业的国产化替代进程将进一步加速。

#### (4) 功率器件技术发展趋势

功率器件的发展包含多个技术路径，包含线宽、器件结构、工艺进步、材料等多个方面，经过不断的发展，功率器件追求不断提高功率密度，实现功耗与成本的最优解，同时实现多种功能的集成。另外，功率器件的材料迭代（如第三代半导体材料）和集成化趋势也日益加强。

功率器件的技术发展趋势如下表所示：

技术路径	发展方向	性能影响
线宽减小	线宽从 10 微米发展至 0.15-0.35 微米，但不追求先进制程	全面提升芯片性能
器件结构	VDMOS 器件中，中低压方面，出现了沟槽型 MOSFET，高压方面，出现了超结 MOSFET	优化提高电压承载能力、额定电流水平和工作频率等指标
工艺进步	同样器件结构下，通过工艺优化改进各项指标	以影响功耗指标为主，但也影响基础指标
材料迭代	从硅基逐步发展至 SiC、GaN 等第三代半导体材料	全面提升芯片性能
集成化趋势	向着小型化、集成化方向发展，如在 MOSFET 中集成过流采样、过热采样单元	降低电源控制器设计及实现工艺的难度，让电源系统安全可靠稳定运行，实现系统低待机功耗

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,066,314,809.40	444,133,465.41	444,039,283.05	140.09	396,926,024.8	396,760,693.99
归属于上市公司股东的	1,022,318,082.17	339,724,176.26	339,725,877.14	200.93	278,600,921.96	278,612,361.57

净资产						
营业收入	213,743,273.35	235,381,937.61	235,381,937.61	-9.19	209,728,901.39	209,728,901.39
归属于上市公司股东的净利润	17,794,984.01	61,123,254.30	61,113,515.57	-70.89	48,465,728.31	48,477,167.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,137,913.16	49,579,201.57	49,569,462.84	-83.59	43,886,209.43	43,897,649.04
经营活动产生的现金流量净额	-36,149,210.95	-11,157,776.87	-11,157,776.87	不适用	50,651,869.38	50,651,869.38
加权平均净资产收益率(%)	3.12	19.77	19.77	减少16.65个百分点	27.59	27.59
基本每股收益(元/股)	0.29	1.11	1.11	-73.87	0.94	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.29	1.11	1.11	-73.87	0.94	0.94
研发投入占营业收入的比例(%)				增加7.20个百分点		

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	61,190,305.47	72,097,035.25	30,053,191.36	50,402,741.27
归属于上市公司股东的净利润	12,344,073.54	16,973,517.61	-7,522,179.22	-4,000,427.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,194,974.28	13,320,228.25	-11,599,820.38	-5,777,468.99
经营活动产生的现金流量净额	-25,479,207.10	24,340,853.51	-24,298,726.64	-10,712,130.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)		12,271						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		6,373						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通出借的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
丁国华	0	11,198,042	15.20	11,198,042		无	0	境内自然人
甘化科工	0	10,555,216	14.32	10,555,216		无	0	境内非国有法人
罗寅	0	9,445,671	12.82	9,445,671		无	0	境内自然人
港鹰实业	0	5,587,234	7.58	5,587,234		无	0	境内非国有法人
港晨芯	0	4,545,500	6.17	4,545,500		无	0	其他
陈锴	0	4,003,350	5.43	4,003,350		无	0	境内自然人
新工邦盛	0	1,578,947	2.14	1,578,947		无	0	其他
禾望投资	0	1,578,947	2.14	1,578,947		无	0	境内非国有法人
大唐汇金	0	1,528,400	2.07	1,528,400		无	0	其他
招港共赢	0	1,239,500	1.68	1,239,500		无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、陈锴、丁国华签署了《一致行动协议》；丁国华担任苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人并持有 20% 合伙份额；罗寅为苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人并持有 35.47% 合伙份额；陈锴持有张家港市港鹰实业有限公司 30% 的股权并担任副总经理、监事。综上，罗寅、张家港市港鹰实业有限公司、陈锴、丁国华与苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

#### 存托凭证持有人情况

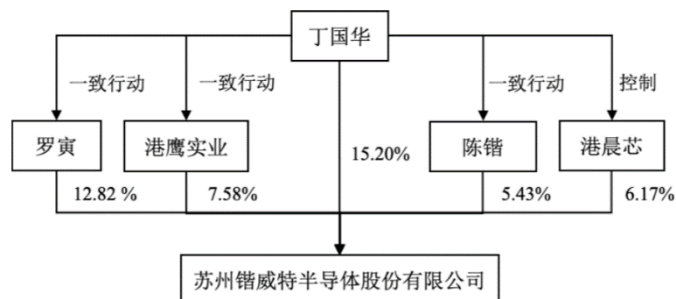
适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

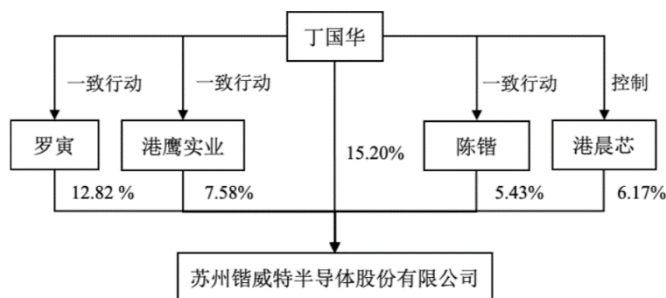
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年度，公司实现营业总收入 21,374.33 万元，较上年同期下降 9.19%；实现归属于母公司所有者的净利润为 1779.50 万元，较上年同期下降 70.89%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 813.79 万元，较上年同期下降 83.59%。2023 年公司的营业收入及利润水平较 2022 年同期均有不同程度的下滑。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用